§7.3 静电场中的导体

静电场 场量

 $ec{E}$

U

基本性质方程

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\varepsilon_{0}}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

一、导体的静电平衡

- (一). 导体的静电平衡条件
- 1、电场对导体内带电粒子的影响

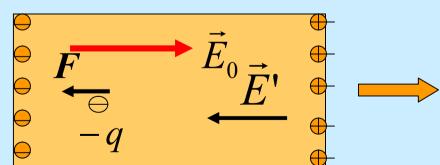
导体内部有两种带电粒子:

正离子: 组成晶格点阵

自由电子:可自由移动

无外场时: 正负电荷分布均匀, 导体不显电性;

有外场时:



$$\vec{\boldsymbol{E}}_0 + \vec{\boldsymbol{E}'} = 0$$

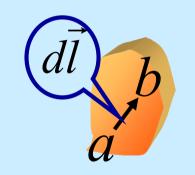
此时电子的定 向运动消失 称为静电平衡

2、静电平衡条件

静电平衡状态: 当导体内部的电场 $\vec{E} = 0$ 时,此时导体达到静平衡状态. 也就是导体内部和表面都无自由电荷的定向移动的状态。

导体处于静电平衡的条件:

$$\vec{E}_{\text{内}} = 0$$
 $\vec{E}_{\overline{\pi}} \perp \overline{\pi}$



导体静电平衡时,导体各点电势相等,即导体是等势体,表面是等势面。这是静电平衡条件的另一种说法。

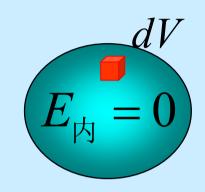
证:在导体上任取两点a和b

$$U_a - U_b = \int_{(a)}^{(b)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \qquad U_a = U_b$$

导体达到静电平衡时,导体内部和导体表面都 没有自由电荷的定向移动,那么电荷在导体内和导 体表面是怎样分布的?

- (二).静电平衡时导体上电荷的分布
- 1、电荷分布

导体可分为实心导体和空腔导体



1) 实心导体

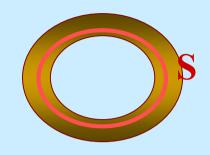
在导体内任取体积元 dV

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$
 由高斯定理 $\sum_i q_i = \int_V \rho \, dV = 0$::体积元任取 $\rho = 0$

结论:导体内的净电荷处处为零(即导体内没有净电荷), 电荷只分布在导体的外表面

2) 空腔导体

由高斯定理可证明空腔内表面的净电荷为零

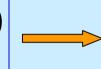


证明: 在导体壳内紧贴内表面作高斯面S

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \boxed{\mathbf{S} \mathbf{m} \mathbf{E} \mathbf{E}} \quad \boxed{\sum_{i} q_{i} = 0} \quad \boxed{\mathbf{E}}$$



$$\sum_{i} q_{i} = 0$$



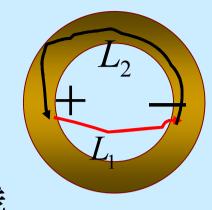
- 两种可能 1、空腔内表面不带电荷
 - 2、空腔内表面带等量异号电荷

对第二种:则必有电力线从正电荷通向负电荷。 做一闭合路径L,使L,沿电力线,L,沿导体内部,则:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_{L_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \iint_{L_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{等于零}$$



只能: $\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 等势, 无电力线

所以空腔内表面没有电荷分布,电荷只能分布在外表面

结论:导体静电平衡时,导体内无电荷,内表面无电荷, 从而只能分布在导体外表面。

既然导体静电平衡时电荷只能分布在导体的外表面,那么,在导体外表面电荷时怎样分布的?

2. 导体表面电荷

设导体表面电荷面密度为 $\sigma(x, y, z)$

相应的电场强度为 $\vec{E}_{\pm}(x,y,z)$

设P是导体外紧靠导体表面的一点,取 一柱形高斯面,一底面过P点

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\vec{k}} \vec{E}_{\pm} \cdot d\vec{S} + \int_{\vec{k}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E_{\pm} dS = \frac{\sigma dS}{c}$$

$$=E_{\pm}dS = \frac{\sigma dS}{}$$

$$E_{\pm} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \longrightarrow \vec{E}_{\pm} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$$

3. 孤立带电导体表面电荷分布

一般情况较为复杂:

孤立的带电导体,电荷分布由实验测定。分布有简单的规律:

- (1) 在表面凸出的尖锐部分(曲率是正值且较大)电荷面密度较大,
 - (2) 在比较平坦部分(曲率较小)电荷面密度较小,
 - (3) 在表面凹进部分带电面密度最小。

导体球表面的电荷面密度与

该处的表面曲率成正比

例

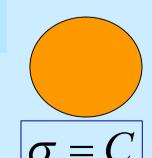
尖端放电

孤立导体

 $U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$

$$\frac{Q}{R} = \frac{q}{r} \quad \text{iff} \quad \frac{\sigma_R}{\sigma_r} = \frac{r}{R}$$

孤立带电 导体球



总结: 导体处于静电平衡时:

- 1、导体是等势体;导体表面为等势面
- 2、导体内部场强处处为0
- 3、电荷只分布在导体表面
- 4、导体球表面的电荷面密度与该处的表面曲率成正比
- 5、导体表面附近的场强 $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{n}$
- 6、有导体时,高斯定理与环路定理仍然成立
- 6、电荷守恒

二、有导体存在时静电场场量的计算

三个原则:

1. 静电平衡的条件

$$E_{\bowtie} = 0$$

or
$$U = c$$

2. 基本性质方程

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i} q_{i}}{\varepsilon_{0}} \qquad \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

3. 电荷守恒定律

$$\sum_{i} Q_{i} = const.$$

例1 无限大的带电平面 σ 的场中平行放置一无限大金属平板

求: 金属板两面电荷面密度

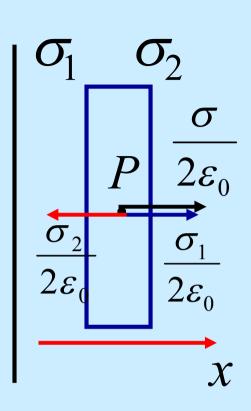
解:设金属板面电荷密度 σ_1 , σ_2

由对称性和电量守恒

$$\sigma_1 = -\sigma_2$$

导体体内任一点P场强为零

$$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} = 0$$



$$\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}\sigma$$

**例2. 已知:导体板A,面积为S、带电量Q,在其旁边相距很近的地方平行地放入面积也为S的导体B

求: 1、A、B上的电荷分布及空间的电场分布

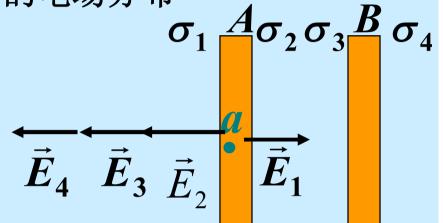
2、将B板接地,求电荷分布

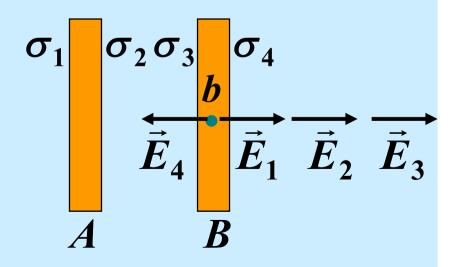
$$\Delta$$
板 $\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q$

B板
$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = 0$$

$$\frac{\alpha + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\frac{\delta E}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} = 0$$



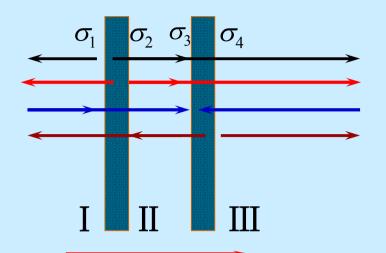


解方程得:

电荷分布

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{2S}$$



场强分布

A 板左侧

$$E_{\perp} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

两板之间

$$E_{\perp} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

B 板右侧

$$E_{\text{II}} = \frac{\sigma_4}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

2、将B板接地,求电荷及场强分布

##接地时 $\sigma'_4 = 0$

$$\frac{\sigma'_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma'_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma'_3}{2\varepsilon_0} = 0$$

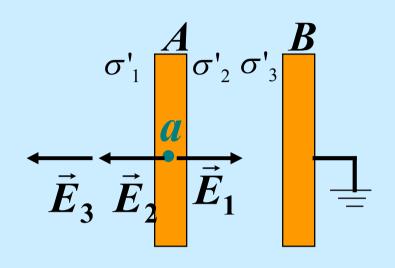
$$\frac{\sigma'_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma'_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma'_3}{2\varepsilon_0} = 0$$

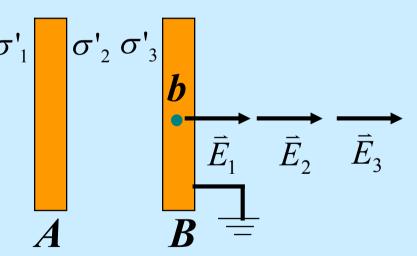


$$A$$
 板 $\sigma'_1S+\sigma'_2S=Q$



$$\sigma'_1 = 0$$
 $\sigma'_2 = -\sigma'_3 = \frac{Q}{S}$



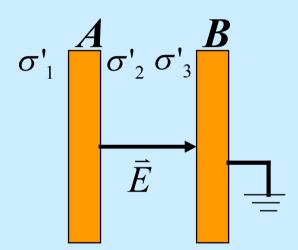


$$\sigma'_1 = 0$$

电荷分布
$$\sigma'_1 = 0$$
 $\sigma'_2 = -\sigma'_3 = \frac{Q}{S}$

场强分布

两板之间
$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$



$$E = 0$$

例3 接地导体球附近有一点电荷,如图所示。

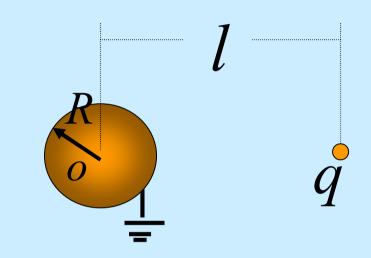
求:导体上感应电荷的电量

解:接地即 U=0

设:感应电量为 Q

由导体是个等势体

O点的电势为0 则



$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l} = 0$$

$$Q = -\frac{R}{l}q$$

**例4、已知 R_1 R_2 R_3 q Q

求:1、电荷及场强分布;球心的电势

2、如用导线连接A、B,再作计算

m: 电荷分布: 球A表面 q 球壳B内表面 -q;高斯定理求得

球壳B外表面 Q+q;电荷守恒得

电场分布
由高斯定理得
$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_3 \end{cases}$$

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_{1} & R_{2} < r < R_{3} \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} & R_{1} < r < R_{2} \\ \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} & r > R_{3} \end{cases}$$

Q+q $R_1 \qquad R_2$ R_3

球心的电势

$$U_{o} = \int_{0}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{0}^{R_{1}} E dr + \int_{R_{1}}^{R_{2}} E dr + \int_{R_{2}}^{R_{3}} E dr + \int_{R_{3}}^{\infty} E dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}} \right) + \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q + Q}{R_{3}}$$

相当于三个带电球面在球心处电势的叠加

2、用导线连接A、B,再作计算 Q+q

连接
$$A \setminus B$$
, $q + (-q)$ 中和

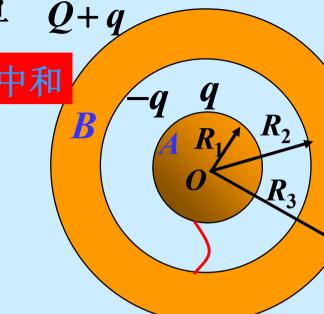
球壳外表面带电 Q+q

$$r < R_3 \qquad E = 0$$

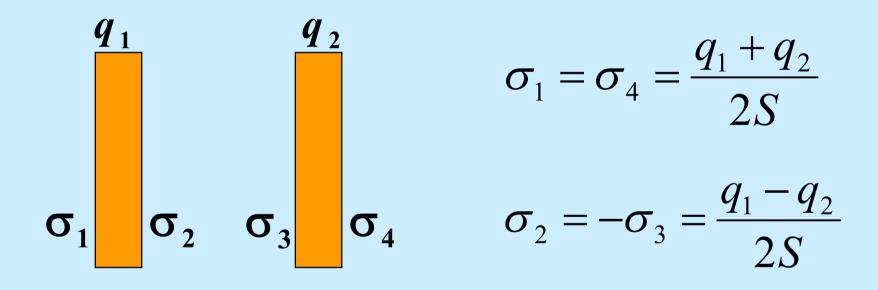
$$r > R_3 \qquad E = \frac{Q + q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$U_{o} = \int_{0}^{R_{3}} E dr + \int_{R_{3}}^{\infty} E dr = \frac{Q + q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{3}}$$

$$U = \int_{r}^{\infty} E dr = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



**练习 已知:两金属板带电分别为 q_1 、 q_2 求: σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4



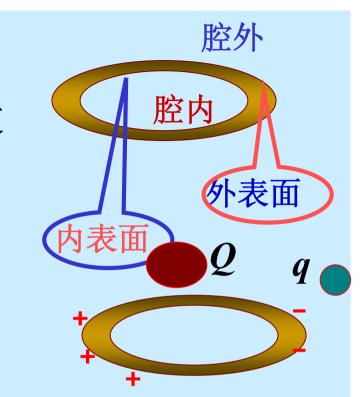
三、导体壳与静电屏蔽

静电平衡时导体内总的场强为零这一规律在技术上用来作静电屏蔽。

导体壳的几何结构

腔内、腔外、内表面、外表面

1、腔内无带电体 内表面没有电荷 腔内无电场



即

$$E_{\rm Eh}=0$$

腔内的场与腔外及壳的外表面的 电量及分布无关

注意: 未提及的问题

1)导体壳外表面是否带电?在腔内

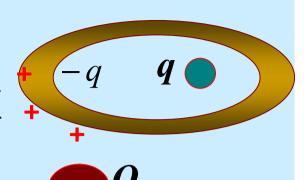
2)腔外是否有带电体?

空心的金属导体会使其腔内的物体不受其任何外场的影响

(二).腔内有带电体

电量分布
$$Q_{extra kn} = -q$$

用高斯定理可证



- 腔内的电场 1)与电量 q 有关;
 - 2) 与腔内带电体、几何因 素、介质有关。

未提及的问题 1)壳外表面是否带电? 2)腔外是否有带电体?

结论: 腔内的场只与腔内带电体及腔内的几何因素、 介质有关

> 或说 在腔内

$$ec{E}_{ ext{nh-km}} + ec{E}_{ ext{nh-km}} = 0$$
电量 带电体

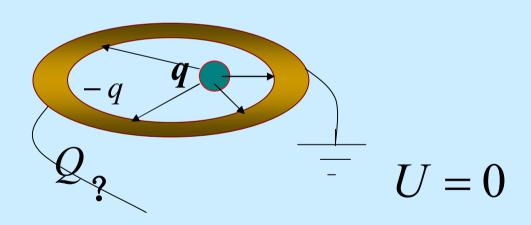
结论: 在腔内

$$ec{E}_{ ext{nh} ag{hh} ag{h} ag{h$$

屏蔽作用

思考: 腔外电荷发生变化,如:改变了位置;改变了大小等,腔内电场将会怎样?

(三).静电屏蔽的装置---接地导体壳



例: 如图 导体 A和B 同心放置

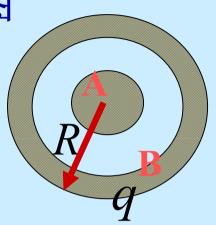
欲求壳B的电势

只需知壳外表面的带电量

和球壳B的外半径

则
$$U_B = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R}$$





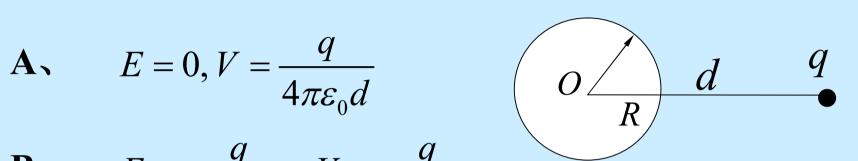
例题、如图所示,将一个电量为q的点电荷放在一个半径 为R的不带电的导体球附近,点电荷距导体球心为d。 设无穷远处为零电势,则在导体球心o点有I

$$\mathbf{A} \cdot \qquad E = 0, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

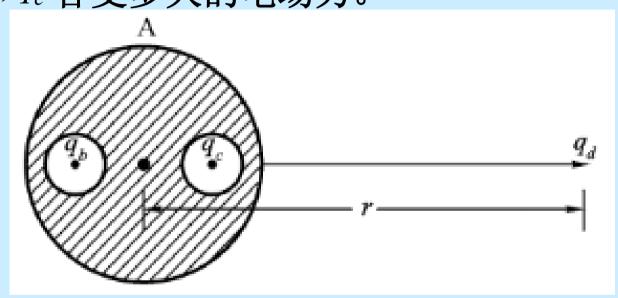
$$\mathbf{B}, \qquad E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$$

$$E = 0, V = 0$$

$$\mathbf{D}, \qquad E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$



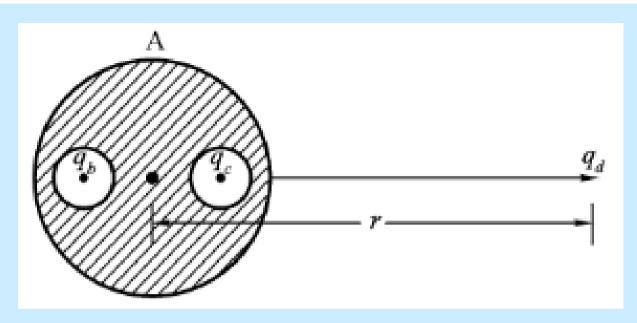
例题、不带电的导体球A内含有两个球形空腔,两空腔中心分别有一点电荷 q_b 、 q_c 。导体球外距导体球较远的 \mathbf{r} 处还有一个点电荷 q_d ,如图所示。试求点电荷 q_d , q_b , q_c 各受多大的电场力。



解:根据导体静电平衡时电荷分布的规律可知,空腔内点电荷的电场线终止于空腔内表面的感应电荷,而它们在导体A外表面的感应电荷可以近似看作均匀分布,因而可以近似看作均匀带电球面对点电荷 q_d 施加作用力,

所以

$$F_d = q_d \frac{(q_b + q_c)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



点电荷 q_a 与导体A外表面感应电荷在球形空腔内激发的电场为零,点电荷 q_b 、 q_c 处于球形空腔的中心,空腔内表面感应电荷均匀分布,所以点电荷 q_b 、 q_c 受到的作用力均为零。